УДК 539.213;535.21

PACS 44.10.+i, 33.15.Bh, 78.30.-J.

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2016.39.66-72

В. Міца¹, О. Фегер², С. Петрецький¹, Р. Голомб¹, В. Ткач²

¹Ужгородський національний університет, Україна, вул. Волошина 54, 88000, Ужгород. e-mail: v.mitsa@gmail.com, f-physics@uzhnu.edu.ua

²Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошіце, Словаччина, парк Ангелінум 9, Кошіце.

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ І БОЗОННИЙ ПІК В СКЛОПОДІБНОМУ с-As₂S₃

При охолодженні і нагрівання в області кріогенних температур залежність теплопровідності в склоподібному с- As_2S_3 від температури демонструє гістерезис.

Ключові слова: халькогенідні стекла, Раман спектроскопія,

теплопровідність стекол, гістерезис теплопровідності.

Вступ

За останні десятиліття в фізиці склоподібного стану основним і найбільш дискусійним питання € природи низькотемпературної теплопровідності і наллишкових низькочастотних (HH)коливань з енергіями меншими за 10 меВ [1-5]. Ha температурній кривій теплопровідності k(T) стекол нижче 1К типовою є залежність близька до T^2 вище 1К в околі 10 К виявлено температурно-незалежне плато і далі, вище плато, спостерігається монотонний ріст теплопровідності [1-10]. Дослідження для склоподібного As₂S₃ k(T)були спочатку проведені в околі плато [2], а в температурному інтервалі понад плато представлені в [3,5]. Метою ланого дослідження, було виявлення зміни теплопровідності As₂S₃ в одному циклі нагрівання та охолодження температурному інтервалі як в околі плато, так і понад плато у взаємозв'язку з положенням бозонного піку (БП) i локалізацією низькочастотних (HH)розгалужених, кільцевих коливань i замкнутих кластерів As_nSm.

Матеріали та методика експерименту

Синтез склоподібних матеріалів системи As-S здійснювався з додатково очищених елементарних компонент чистоти "ОСЧ" В-5 в кварцевих ампулах. компоненти зважувались Вихідні 3 точністю ло 10⁻⁷ кг і насипались V відпалені кварцеві ампули, які попередньо оброблялись концентрованою азотною кислотою і промивались дистильованою волою. Наповнені шихтою ампули за пальника допомогою газокисневого прогрівалась до температури 400-450 К для усунення парів води і запаювались під вакуумом порядку 10⁻⁴ торр.



Рис. 1. Зміна потужності нагрівника в процесі охолодження та нагрівання (пояснення у вставці).

Далі проводився повільне нагріванням в трубчастій електричній печі до температури 600 °С, витримкою при цій температурі та загартовуванням на повітрі до кімнатної температури зі швидкістю 1 град/с. Всі зразки відпалювались з метою

вилучення залишкових напруг, які виникають в них при загартуванні. В першому циклі дослідження k(T) від 100 К до температури 2 К проводились при охолодженні зразка. Другий цикл вимірювань, включав в себе як охолодження від 100 К до температури 2 К, так і нагрівання в зворотному напрямку. Зміна потужності нагрівника в процесі охолодження відповідно до умов вимірів на комплексі представлена на рис.1 (криві 2,3), а процес нагрівання відображає крива 1 на рис. 1. Часова залежність різниці температур на гарячому і холодному кінцях зразка ілюструє рис.2. Запис НЧ Раман спектрів при кімнатній температурі було здійснено на експериментальній установці ДФС-24, а дані вимірювань при T=10 К були взяті з [7]. Методика розрахунку коливань кластерів описана в [4,].



Рис.2. Часова залежність різниці температур на холодному і гарячому кінцях зразка в процесі проведення вимірів (пояснення у вставці).

Результати та їх обговорення

При охолодженні зразка в обох незалежних циклах вимірювань в межах похибки, співпали як абсолютні значення k так і форма експериментальних кривих (рис.3,криві1,2). В межах від 3,6К до 10,7К (0,31-0,92)meB, рис.3) підтверджено виявлене раніше в с-As₂S₃ [3,5] «плато», тангенс нахилу k(T) якого рівний нулю (tga=0). Відрізки k(T), що знаходиться вище плато, в межах температур від 10.7К до 111К для обох залежностей k(T) з різних циклів вимірювань (рис.3, криві 1,2),

мають лінійну залежність з нахилом tgα=0.0003.



Рис.3. Залежності k(T) при охолодженні та нагріванні с-As₂S₃ в одному циклі вимірювань (криві 1,3) та охолодженні (крива 2).

Подібна температурна залежність k(T) вище плато була виявлена [8] для с-GeS₂. В шиклі вимірювань одному низькотемпературної теплопровідності с-As₂S₃, після охолодження, в процесі нагрівання в області від 1 до 10 меВ ,було зафіксовано відмінності ходу k(T) (рис.3, крива 3) від лінійної залежності k(T) при охолодженні (рис.3,криві1,2) і виявлено явище гістерезису. Відомо, шо В експериментах по дослідженню густини (ГКС) коливальних станів $g(\omega)$ склоподібного і кристалічного As₂S₃ за непружнього допомогою розсіювання нейтронів, в цій області для c-As₂S₃ спостерігається надлишок $g(\omega)/\omega^2$ 3 при 2,65 меВ, де теорія максимумом Дебая передбачає сталу величину [1].

На різницевих спектрах $\Delta k(T)$, взятих як різниця між k(T) при нагріванні і охолодженні с-As₂S₃ в одному циклі вимірювань, виявлено (рис.4), шо положення максимуму $\Delta k(T)$ добре узгоджується з положенням максимуму $g(\omega)/\omega^2$, виявленого [6] в с-As₂S₃ при нейтронографічних дослідженнях. Однак, крім складних у експеримен-тальному відношенні нейтронографічних досліджень. положення максимуму $g(\omega)/\omega^2$



Рис.4. Різницева залежність k(T) при нагріванні і охолодженні с-As₂S₃ в одному циклі вимірювань (крива 3) та положення густини станів бозонного піку при 300 К (крива 2) та 10 К (крива 1) із досліджень НЧ Раман спектрів [7].



Рис. 5. Теплопровідність вище плато при нагріванні с-As₂S₃ (крива 1) та густина низькочастотних станів $g(\omega)$ (крива 2), розрахована із НЧ Раман спектру

Згілно теоретичними розрахунками 3 спостережувана Iексп експерименті В інтенсивність В НЧ області спектру визначається співвідношенням [7]: $C(\Lambda u) \alpha(\Lambda u) [n(\Lambda$ +1

$$I_{e\kappa cn}\left(\Delta \nu\right) = \frac{C\left(\Delta \nu\right)g\left(\Delta \nu\right)[n(\Delta \nu)]}{\Delta \nu}$$

де $C(\Delta v)$ – коефіцієнт фотон-фононного зв'язку; $g(\Delta v) - \Gamma KC$;

$$n(\Delta \nu) = \frac{1}{\exp^{\left(\frac{h\nu}{kT}\right)} - 1} - \text{Бозе фактор}$$

Враховуючи це, приведений спектр:

$$I_{npue}(\Delta \nu) = \frac{I_{excn}(\Delta \nu)}{\Delta \nu [n(\Delta \nu) + 1]} = \frac{C(\Delta \nu)g(\Delta \nu)}{(\Delta \nu)^2}$$
(4.2)

Беручи до уваги дані нейтронографічних досліджень [], можна вважати, що в області від 1 до 10 меВ (1меВ=8 см⁻¹) $C(\Delta v) \approx \Delta v$. Тоді :

$$g(\Delta \nu) = \frac{I_{npue}(\Delta \nu)(\Delta \nu)^2}{C(\Delta \nu)} \approx I_{npue}(\Delta \nu)\Delta \nu = \frac{I_{excn}(\Delta \nu)}{[n(\Delta \nu)+1]}$$



Рис.6. Спостережувані $I_{експ.}$ (криві 1,3) та приведені $I_{прив.}$ (криві 2,4) НЧ Раман спектри с-As₂S₃,As₂₂S₇₈ і розраховані НЧ коливання розгалужених кластерів As_nS_m

На рис.5 приведені дані залежності k(T) вище плато при нагріванні с-As₂S₃ та результати розрахунку $g(\omega)$ із НЧ спектру по приведеним вище співвідношенням. Результати розрахунків $g(\omega)/\omega^2$ взяті із досліджень НЧ Раман спектрів с-Аs₂S₃ при Т=10 К [7] та НЧ спектрів знятих нами при кімнатній температурі (рис.6) приведені на рис.4 (криві 1 і 2 відповідно). Положення максимуму $g(\omega)/\omega^2$ при 2,19 меВ (рис.4 крива 1) задовільно узгоджується з положенням максимуму $g(\omega)/\omega^2$, виявленого нейтронографічним методом. [6] Положення «центру ваги» і форма асиметричної складної смуги $\Delta k(T)$ і кривої $g(\omega)/\omega^2$ в області 1-5 меВ добре узгоджуються (Рис.4).

Одним із модельних підходів, що пояснює природу низькочастотних надлишкових станів, є модель локалізованих низько-



Рис.7. Молекулярні, ланцюгові, кільцеві і замкнуті кластери As_nS_m

частотних (НЧ) коливних мод, які можуть виникати в некристалічних матеріалах внаслідок розупорядкування [4]. Слід відмітити, що такого типу НЧ коливання простих пірамідальних відсутні для молекулярних структурних одиниць (с.о.) AsS₃ (рис.5) за допомогою яких типу раніше описували ближній порядок в с- As_2S_3 в молекулярному наближенні будови скла [12]. Перехід до концепції порядку середнього В стеклах i кластерного опису будови стекол [12] дозволив розрахувати НЧ коливання в модельних ланцюгових кластерах As_nS_m [13]. Також відомо, що в кристалічному к-As₂S₃ 12-членні кільця на основі пірамід формують $AsS_{3/2}$ двохмірну (2D)шарувато-ланцюгову структуру кристалу [12]. Імовірнісний розрахунок формування кластерів в матриці структури с-As₂S₃ показав. що спільним структурним мотивом с- і к- As₂S₃ можуть бути 12членні кільця (i=12, рис.7). Однак з рис.8 легко бачити, що такі коливання займають в Раман спектрі с- As₂S₃ по відношенню аналогу кристалічного до обмежену область частот і наявність широких «вікон» вказує на можливий вклад в незаповнені області (вікна) коливань від інших типів кластерів (рис.7), що можуть

виникати в матриці структури внаслідок деполімеризації багаточленних кілець.



Рис. 8. Раман спектр склоподібного (с), полікристалічного (пк.) As₂S₃ та їх різницевий спектр

Розрахунок частот валентних коливань зв'язків As-S в кластерах As_nS_m різного типу (рис.6) приведений в [13] показав, що вони можуть заповнювати весь простір від 290 до 420 см⁻¹. Тому далі зосередимось на аналізі розрахунків НЧ коливань кластерів As_nS_m. Найнижчі коливні моди 6-, 8-, 10та 12- членних кілець (рис.7) розміщені відповідно при 33, 18, 11, and 9 см⁻¹. При переході від ланцюгових As₂S_{1+4/2} до розгалужених кластерів $As_{2+4/3}S_5$ спостерігається зсув НЧ коливань від 31 ст⁻¹ до 13 ст⁻¹ відповідно. Рис.6 та рис. 9 ілюструють можливий вклад торсійних коливань НЧ розгалужених As_nS_m кластерів (див. рис.7), їх вклад в густину станів і надлишкові коливання . Важливо підкреслити, що з ростом числа атомів в розгалужених кластерах $(As_2S_3)_n$, n=1-3, їх енергія, виражена через атомні одиниці, зменшується від -41.5 (кл.-As₂S₃) до -124.6 Хартрі (кл. As₆S₉). Пониження енергії утворення кластерів більших розмірів вказує на збільшення імовірності їх формування в матриці структури скла. Отримані результуючі частоти коливань атомів у кластерах представлених на рис. 7 модельовались кривими Лоренца (рис.9). Напівширина кривих Лоренца складала 10 см⁻¹. Симульовані низькочастотні коливання кластерів As_nS_m (див. рис.6) і їх вклад в $g(\omega)/\omega^2$ густину станів $g(\omega)$ і k(T) понад плато, (рис.9) можуть вносити



Рис.9. Частотні коливання кластерів As_nS_m.

торсійні коливання великих кільцевих і розгалужених кластерів, починаючи з 1 меВ (рис.9)

Висновки

В області кріогенних температур в с-As₂S₃ при нагріванні і охолодженні вперше виявлено гістерезис температурної залежності теплопровідності k(T).

В с-As₂S₃ на залежності k(T) в межах від 3,6 К до 10,7 К (0,31-0,92 meB,) підтверджено наявність «плато», (tg α =0).

Залежності k(T) з різних циклів охолодження в температурному інтервалі від 10.7К до 111К, що знаходиться вище плато, в межах точності вимірювань, мають лінійну залежність з нахилом $tg\alpha=0.0003$.

Вклад в теплопровідність і Бозонний пік можуть вносити торсійні коливання кільцевих і розгалужених кластерів, починаючи з енергій (частот) 1 меВ (8 см⁻¹).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- 1. Bermann R. Thermal conduction in solids // Clarendon Press, Oxford. - 1976.
- Keller R. C., Pohl R. Thermal Conductivity and Specific Heat of Noncrystalline Solids // Phys. Rev. B-4. -1971. - PP. 2029-2041
- Stephens R. B. Low-temperature specific heat and thermal conductivity of noncrystalline dielectric solids //Phys. Rev. B 8. - 1973. - PP. 2896-2903
- 4. Holomb R., Mitsa V. Boson peak of As_xS_{1-x} glasses and theoretical calculations of low frequencies clusters vibrations // Solid State Commun. Vol. 129. 2004. PP. 655-659.
- Leadbetter A.J., Jeapes A.P., Waterfield C.G., Maynard R., Conduction thermique des verres aux basses temperatures // Journal de Physique.- Vol. 38 (1), -1977. -PP. 95-99.
- Malinovsky V.K., Novikov V.N., Parshin P.P., Sokolov A.P., Zemlyanov M.G. Universal form of the low-energy (2-10 meV) vibrational spectrum of glasses // Europhysics Letters.- Vol. 11. -1990. - PP. 43-47.

- Sokolov A.P, Kisliuk A., Quitmann D., Duval E. Evaluation of density of vibrational states of glasses from lowfrequency Raman spectra // Phis.Rev.-48. - 1993. - PP. 7692-8002.
- Nakayama T., Orbach R.L.. On the increase of thermal conductivity in glasses above the plateau region // Physica B. V 263-264. 1999. PP.261-263.
- Jagannathan A., Orbach R., and Entin-Wohlman O.. Thermal conductivity of amorphous materials above the plateau. // Phys. Rev. B. - V39. - 1989. - PP 13465 -1377
- Feher A., Yurkin I.M., Deich L.I., Orendach M., Turyanitsa I.D. The comparative analysis of some lowfrequency vibrational state density models of the amorphous materials — applied to the As2S3 glass // Physica B. - Vol. 194 – 196, - 1994. - PP. 395 - 396.
- Vateva E., Terziyska B., Arsova D.. Lowtemperature specific heat and thermal conductivity of ternary chalcogenide glasses// Journal of Optoelectronics and end Advanced materials. - V9, - 2007. -PP. 1965 – 1973.

- Mitsa V., Holomb R., Veres M., Koós M.. Raman szórás nanoszerkezetű kalkogenid üvegekben // Hungarian Academy of Sciences. Budapest: Intermix Kiadó, -2009. - 104 p.
- 13. Holomb R. M., Mitsa V. M.. Simulation of raman spectra of As_xS_{100-x} glasses by

Стаття надійшла до редакції 26.05.2016 р.

the results of ab initio calculations of AsnSm clusters vibrations // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - V6, - 2004. - PP. 1177 – 1184.

В. Мица¹, О. Фегер², С. Петрецкий¹, Р. Голомб¹, В. Ткач²

¹Ужгородский национальный университет, Украина, ул. Волошина 54, 88000, Ужгород. e-mail: v.mitsa@gmail.com, f-physics@uzhnu.edu.ua

²Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице, Словакия, парк Ангелинум 9, Кошице.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И БОЗОННЫЙ ПИК В СТЕКЛООБРАЗНОМ с-As₂S₃

При охолоденни и нагрев в области криогенных температур зависимость теплопроводности в стекловидном с-As2S 3 от температуры демонстрирует гистерезис.

Ключевые слова: халькогенидных стекла, Раман спектроскопия, теплопроводность стекол, гистерезис

PACS 44.10.+i, 33.15.Bh, 78.30.-J.

V.Mitsa¹, A. Feher², S.Petretskij¹, R.Holomb¹, V.Tkac² ¹Uzhorod NationalUniversity, Uktraine, 54 Voloshin Str., 88000, Uzhgorod

e-mail: v.mitsa@gmail.com, f-physics@uzhnu.edu.ua

²P.J.Safarik University in Kosice, Institute of Physics, Park Angelinum 9

LOW-TEMPERATURE THERMAL CONDUCTIVITY AND BOSON PEAK IN THE GLASSY g-As₂S₃

Background: Thermal conductivity and heat capacity with low temperature anomalies, the Boson peak in the in glassy materials are still not clearly understood and are matter of debate.

Materials and methods: We studied thermal conductivity in g-As2S3 between 2 and 100 K, depends k(T) for cycles cooling and heating.

Results: Thermal conductivity is weakly temperature κ (T) dependent from 2 to 10 K showing a plateau region during both cooling and heating.

The jump of value in κ (T) dependence compare with cooling κ (T) curves was found during heating g-As2S3. The values show that the jump of κ (T) is greater than the accuracy of the measurement producing an appreciable deviation from k values taken during cooling. The appearance of hysteresis of κ (T) during heating was found in range of temperature from 11 to 60 K. Difference curve of κ (T) (heating minus cooling) is complex asymmetric peak in energy range from 1 to 10 meV and reproduces the experimental lowtemperature Boson peak (BP) .Intensity of it being proportional to the density of states (g (ω)) by the rule of g (ω) / ω 2. Our spectroscopic theoretical and experimental studies of glass structure in cluster approximation have shown that the nature of excitations in the low frequency region of the spectrum might be originate from rich a variety of vibrational properties clusters vibrations resulting from atomic scale disorder. In order to understand how these low frequency-modes depended on system clusters size we focus of attention in this work on the modes which might have vibrational character and be involved in measured low temperature thermal conductivity anomalies and Boson peak in g- As2S3.

Conclusion: In region the cryogenic temperatures in g-As₂S₃ when heating and cooling first discovered hysteresis temperature dependence of the thermal conductivity k (T). In g-As₂S₃ regardless of k(T) in the range of 3.6K to 10K (0,31-0,92 meV) confirmed the presence of «plateau» (tg $\alpha = 0$).

Keywords: chalcogenide glass, Raman spectroscopy, thermal conductivity of glass, Boson peak.

PACS Number: 44.10.+i, 33.15.Bh, 78.30.-J.

REFERENCES

1. Bermann, R. (1976) "Thermal conduction in solids", Clarendon Press, Oxford.

2. Keller, R. C., Pohl, R. (1971), "Thermal Conductivity and Specific Heat of Non-crystalline Solids", Phys. Rev., B-4, pp. 2029-2041.

3. Stephens, R. B. (1973) "Lowtemperature specific heat and thermal conductivity of non-crystalline dielectric solids", Phys. Rev., B-8., pp. 2896-2903.

4. Holomb, R., Mitsa, V. (2004) "Boson peak of AsxS1-x glasses and theoretical calculations of low frequencies clusters vibrations", Solid State Commun., 129, pp. 655-659.

5. Leadbetter, A.J., Jeapes, A.P., Waterfield, C.G., Maynard, R., "Conduction thermique des verres aux basses temperatures", Journal de Physique, 38 (1), pp. 95-99.

6. Malinovsky, V.K., Novikov, V.N., Parshin, P.P., Sokolov, A.P., Zemlyanov, M.G. (1990), "Universal form of the lowenergy (2-10 meV) vibrational spectrum of glasses", Europhysics Letters, 11, pp. 43-47.

7. Sokolov, A.P., Kisliuk, A., Quitmann, D., Duval, E. (1993), "Evaluation of density of vibrational states of glasses from low-frequency Raman spectra", Phis.Rev., 48, pp. 7692-8002.

8. Nakayama, T., Orbach, R.L. (1999), "On the increase of thermal conductivity in glasses above the plateau region", Physica B, Vol. 263-264, pp. 261-263.

9. Jagannathan, A., Orbach, R., Entin-Wohlman, O. (1989), "Thermal conductivity of amorphous materials above the plateau", Phys. Rev. B, Vol. 39, pp. 13465 –1377

10. Feher, A., Yurkin, I.M., Deich, L.I., Orendach, M., Turyanitsa, I.D. (1994) ,"The comparative analysis of some low-frequency vibrational state density models of the amorphous materials — applied to the As2S3 glass" Physica B, Vol. 194 – 196, pp. 395 -396.

11. Vateva, E., Terziyska, B., Arsova, D. (2007), "Low-temperature specific heat and thermal conductivity of ternary chalcogenide glasses", Journal of Optoelectronics and end Advanced materials, Vol. 9, pp. 1965 – 1973.

12. Mitsa, V., Holomb, R., Veres, M., Koós, M. (2009), "Raman szórás nanoszerkezetű kalkogenid üvegekben". Hungarian Academy of Sciences., Budapest: Intermix Kiadó, pp. 104.

13. Holomb, R. M., Mitsa, V. M. (2004), "Simulation of raman spectra of AsxS100-x glasses by the results of ab initio calculations of AsnSm clusters vibrations", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 6, pp. 1177 - 1184.

© Ужгородський національний університет